Previous Doc Next Doc Go to Doc# First Hit

Generate Collection

L2: Entry 7 of 12

File: DWPI

Dec 2, 2003

DERWENT-ACC-NO: 1998-515039

DERWENT-WEEK: 200382

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Measurement of diameter of crystal - using photometry

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

SUMITOMO SITIX CO LTD

SUMIN

PRIORITY-DATA: 1997JP-0040151 (February 7, 1997)

Search ALL Clear.

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE
 PAGES
 MAIN-IPC

 JP 3473313 B2
 December 2, 2003
 007
 C30B015/26

 JP 10226592 A
 August 25, 1998
 007
 C30B015/26

APPLICATION-DATA:
PUB-NO

APPL-DATE APPL-NO DESCRIPTOR

JP 3473313B2 February 7, 1997 1997JP-0040151

JP 3473313B2 JP 10226592 Previous Publ.

JP 10226592A February 7, 1997 1997JP-0040151

INT-CL (IPC): C30 B 15/26; H01 L 21/208

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10226592A

BASIC-ABSTRACT:

A single crystal is pulled up from a crystal melt by the <u>Czochralski</u> method with the single crystal rotating in the peripheral direction. Photometry is applied to the interface position of the single crystal and the melt with a camera installed at the top of oblique. The intersections at both the sides are detected from a change in brightness at the intersection of a <u>fusion ring</u> evolved at the circumference of the single crystal and the photometric line of the camera. Where, the measurement of the dia. of the crystal comprises: (a) independently detecting intersections at both the sides, respectively; (b) removing the component caused by the swinging of the single crystal from the intersection detection data at both the sides; (c) obtaining a difference in timing of a variation in the intersection positions at both the sides determined by the position of the photometric line of the camera; (d) comparing the intersection detection data at both the sides after removing the component caused by the swinging of the single crystal by removing the timing difference to obtain intervals between the intersections at both the sides.

USE - The method optically measures in high accuracy the dia. of the single crystal in pulling up the single crystal by the Czochralski method.

ADVANTAGE - The method measures in high accuracy the dia. of the single crystal over the entire circumference of the crystal including the vicinity of the crystal habit line. The result improves the yield, productivity, and quality of the single crystal.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/8

TITLE-TERMS: MEASURE DIAMETER CRYSTAL PHOTOMETER

DERWENT-CLASS: L03 U11

CPI-CODES: L04-B01;

EPI-CODES: U11-B01;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1998-154845 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-402592

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-226592

(43)公開日 平成10年(1998) 8月25日

(51) Int.Cl.⁸

識別記号

FΙ

C30B 15/26

C30B 15/26 # H01L 21/208

H01L 21/208

P

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平9-40151

(22)出願日

平成9年(1997)2月7日

(71)出顧人 000205351

住友シチックス株式会社 兵庫県尼崎市東浜町1番地

(72) 発明者 高梨 啓一

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友金属工業株式会社内

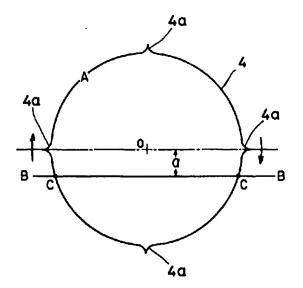
(74)代理人 弁理士 生形 元重 (外1名)

(54) 【発明の名称】 結晶直径測定方法

(57)【要約】

【課題】 CZ法による単結晶の引上げにおいて、単結晶4の外面に生じる晶癖線4aの部分も含め、結晶全周にわたって結晶直径を高精度に測定する。

【解決手段】 一次元CCDカメラ8によりフュージョンリングAと測光ラインBの交点C、Cの位置を検出する。単結晶4の品癖線4aが測光ラインB-Bを通過するときに、両側の交点位置が変動する。結晶中心Oから測光ラインBが離れていることにより、両側の交点位置 変動にタイミング差 θ が生じる。両側の交点位置検出データから交点間隔を求める際に、タイミング差 θ を取り除く。また、両側の交点位置検出データの周波数成分を求め、単結晶の揺れによる低次の周波数成分を除去することにより、単結晶の揺れによる影響を取り除く。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶融液から単結晶を周方向に回転させ ながら引上げるCZ法による単結晶の引上げにおいて、 斜め上方に設置されたカメラにより単結晶と融液の界面 位置を測光し、単結晶の周囲に生じるフュージョンリン グとカメラの測光ラインとの交点での輝度変化から両側 の交点位置を検出する際に、両側の交点位置をそれぞれ 独立に検出する工程と、両側の交点位置検出データから 単結晶の揺れによる成分を取り除く工程と、カメラの測 光ラインの位置により決定される両側の交点位置変動の 10 タイミング差を求める工程と、単結晶の揺れによる成分 を取り除いた後の両側の交点位置検出データを、前記タ イミング差を取り除いて比較し、両側の交点の間隔を求 めることにより単結晶の直径を測定する工程とを包含す ることを特徴とする結晶直径測定方法。

【請求項2】 両側の交点位置検出データから単結晶の 揺れによる成分を取り除くために、両側の交点位置検出 データの各周波数成分を求め、各周波数成分のなかから 単結晶の揺れの周期に対応する低次の周波数成分を除去 することを特徴とする請求項1に記載の結晶直径測定方 20 法。

【請求項3】 単結晶の揺れの周期に対応する低次の周 波数成分を除去するに当たり、単結晶が揺れていないと き或いはその揺れが非常に小さいときの周波数成分よ り、単結晶の形状による成分をオフラインで事前に調査 しておき、この成分を除去対象から除外することを特徴 とする請求項2に記載の結晶直径測定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CZ法(チョクラ 30 ルスキー法)により単結晶を引上げる際に、その単結晶 の直径を光学的に精度よく測定する結晶直径測定方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】半導体の原料となる単結晶を製造する方 法の一つとしてCZ法による引上げがある。CZ法で は、図1に示されるように、CZ炉の炉体1に設置され たるつぼ2内に結晶融液3が満たされ、その融液3から 単結晶4が回転装置6により回転させられながら引上装 置5により引上げられる。このとき、ヒータ7による融 40 液3の加熱を一様にするために、ヒータ7の加熱中心と 液面位置が一定となるように、るつぼ2が上昇制御され 3.

【0003】引上げ中の単結晶4は、上端部および下端 部においては各々目的とする形状に一致させるのが望ま しく、また直胴部分や種結晶部分においては目標値に等 しい均一直径とすることが望まれる。加えて、単結晶4 の断面形状の真円からのズレを表わす変形率〔(最大径 -最小径)/最小径〕を許容値以下にする必要もある。

の一つである酸化誘起積層欠陥(以下OSFと称す)の 密度を低く抑える必要がある。OSFとは結晶内に固溶 した酸素が結晶の酸化熱処理の際に酸化物として析出す る現象が原因で起こる積層欠陥のことである。このOS Fの密度は引上速度を上昇させれば、結晶をその分急冷 させることができるために低く抑えることができる。そ のため引上速度を上げる必要がある。引上速度の上昇は

【0005】しかしながら、引上速度を上げると、上記 変形率が増大し許容値を超えるために、歩留りが低下す る。そのため変形率の許容範囲内で引上げ可能な最適引 上速度を設定することが、単結晶の歩留り向上、生産性 向上、品質確保等の点から必要となる。ここに引上げ中 の単結晶の直径を正確に測定し、正確な変形率を算出す ることの重要性がある。

生産効率を向上させる点からも有益である。

【0006】CZ法による引上げ中に単結晶の直径を測 定する方法としては、引上げられた単結晶の重量から直 径を算出する方法(以下重量法とする)と、一次元CC Dカメラ等の光学機器を用いて直径を測定する方法(以 下光学法とする)の2つが知られている。

【0007】ところで、CZ法による単結晶の引上げで は、図3に示されるように、単結晶4の外周面に晶癖線 と呼ばれる突起4 aが周方向に規則的に生じる。この突 起4aは結晶軸方向に延び、単結晶4の結晶方位に固有 な周方向位置に生じる。変形率を算出する場合この晶癖 線の部分の直径を正確に測定する必要があるが、重量法 では引上げられた単結晶の重量と長さとから結晶直径を 算出する関係から、平均直径しか測定できず、晶癖線の 部分の直径を測定することはできない。その点、光学法 は、融液と単結晶の界面に生じる輝度の高いフュージョ ンリングの直径を光学的に測定するために、晶癖線の部 分の直径を測定することができる。

【0008】この光学法では、図1に示されるように、 炉体1の上端部に設けた窓9を通して単結晶4と融液3 の界面が一次元CCDカメラ8により直線的に測光され る。そして、図2に示されるように、単結晶4の周囲に 生じるフュージョンリングAと一次元CCDカメラ8の 測光ラインB-Bとの交点C、Cでの輝度変化から交点 C, Cの位置を検出し、単結晶4の直径を測定する。

【0009】具体的には、単結晶4が1回転する間、交 点C, Cの位置検出を続け、下式により交点C, Cの間、 隔 $W(\alpha)$ を求めることにより、単結晶4の全周にわた ってその直径を測定する。

 $W(\alpha) = L(\alpha) - R(\alpha)$

 $L(\alpha)$, $R(\alpha)$: 交点C, Cの位置検出データ

α:単結晶の回転角

【0010】この場合、一次元CCDカメラ8の測光ラ インB-Bが結晶中心Oを通るように一次元CCDカメ ラ8を設置すると、結晶直径が減少したときにフュージ 【0004】一方、結晶品質に関しては、その評価項目 50 ョンリングAが単結晶4の陰となり、測定誤差を生じた

り、場合によっては直径測定が不可能になることがあ る。そのため、一次元CCDカメラ8の測光ラインB-Bが結晶中心Oよりカメラ側(手前側)に設定される。 この場合、一次元CCDカメラ8が測定した交点C, C の間隔Wから、結晶直径が次式により算出される。

 $D = (W^2 + 4a^2)^{1/2}$

D:結晶直径

W:交点C,Cの間隔

a:結晶中心Oから測光ラインB-Bまでの距離 [0011]

【発明が解決しようとする課題】従来の光学法では、前 述した通り、交点C, Cの位置検出データL(α), R (α) の差 $(L(\alpha) - R(\alpha))$ から交点C, Cの間 隔Wが求められる。単結晶の結晶方位が(100)の場 合、図3に示されるように、単結晶4の外面に90°の 間隔で晶癖線4aが生じ、一次元CCDカメラ8の測光 ラインB-Bが結晶中心Oを通るときは、結晶中心Oを 挟んで対象位置にある2つの晶癖線4a,4aが同時に 測光ラインB-Bを通過するので、交点C, Cの位置検 出データ $L(\alpha)$, $R(\alpha)$ の差から、晶癖線4aの付 20 近も含めて単結晶4の直径が比較的高精度に全周測定さ れる。

【0012】しかし、実際の引上げでは、前述した通 り、測光ラインB-Bが結晶中心Oから離される。その 場合は、結晶中心Oを挟んで対象位置にある2つの晶癖 線4a, 4aは測光ラインB-Bを同時に通過せず、一 方の通過の後に他方が通過する。そのため、交点C、C の位置検出データL(α), R(α)の差から交点C, Cの間隔Wを求める従来の光学法では、 晶癖線4aの付 近で直径測定精度が著しく低下する。

【0013】また、現在のるつぼの上昇制御において は、正確な液面位置検出方法が実用化されていないため に、液面位置に誤差が生じる。その結果、一次元CCD カメラ8の測光ラインB-Bが初期の設定位置からず れ、結晶中心〇から測光ラインB-Bまでの距離aが変 動する。そのため測定された直径Dに誤差が含まれる。 【0014】この問題を解決するために、一次元CCD カメラ8の測光ラインB-Bをそのラインと直角な方向 に移動させ、移動の前後に測定した結晶直径と測光ライ ンB-Bの移動距離とから真の直径値を求める方法は、 特開昭63-256594号により提案されている。し かし、この方法によっても測光ラインが結晶中心から離 れていることによって生じる晶癖線付近での直径測定精 度の低下は避けられない。

【0015】このような状況を背景として、本発明者 は、フュージョンリングAとカメラの測光ラインB-B との交点C、Cでの輝度変化から両側の交点位置を検出 する際に、両側の交点位置をそれぞれ独立に検出し、両 側の交点位置検出データL(α), R(α)から、カメ ラの測光ラインの位置により決定される両側の交点位置 50 上げるCZ法による単結晶の引上げにおいて、斜め上方

変動のタイミング差 θ を求め、そのタイミング差 θ を取 り除いて両方の交点位置検出データ $L(\alpha)$, $R(\alpha)$ を比較することにより、測光ラインB-Bが結晶中心O から離れていることに起因して生じる晶癖線付近での直 径測定精度の低下を防ぐ単結晶の直径測定方法を先に開 発した(特願平7-282460号)。

【0016】即ち、CZ法により引上げられる単結晶 は、前述した通りその結晶方位に固有な外面周方向位置 に晶癖線を生じる。例えば結晶方位が(100)の場合 10 は90°おきに晶癖線が生じる。引上げ中の単結晶は周 方向に回転していることから、一次元CCDカメラの測 光ラインB-Bを晶癖線が横切るときに、フュージョン リングAと測光ラインB-Bの交点位置が変動する。

(100)の場合は90°おきに交点位置が変動する。 【OO17】測光ラインB-Bが結晶中心Oを通るとき は、この交点位置変動が両側の検出位置で同時に生じる が、測光ラインB-Bが結晶中心Oから離れると、両側 の交点位置変動の発生タイミングにズレが生じる。そし T、このタイミング差 θ は結晶中心Oから測光ラインB- Bまでの距離が長くなるに従って大となる。

【0018】本発明者が先に開発した単結晶の直径測定 方法では、両側の交点位置検出データし(α), R (α) から両側の交点位置変動のタイミング差 θ を求 め、両側の交点位置変動のタイミング差母を取り除い C、両方の位置検出データL (α) , R (α) を比較す ることにより、測光ラインB-Bが結晶中心Oから離れ ていることに起因して生じる晶癖線付近での直径測定精 度の低下が防止される。

【0019】しかしながら、CZ法による単結晶の引上 30 げでは、引上げ中の単結晶が1回転する間に1~4の周 期で揺れる。一次元CCDカメラから見て単結晶が左右 に揺れる場合は、両側の交点位置検出データL(α), $R(\alpha)$ の差をとることにより、揺れの影響が排除され るので、問題を生じないが、単結晶が前後に揺れる場合 は測光ラインB-Bから結晶中心Oまでの距離が変化す ることにより、直径測定精度が低下する。実際の引上げ での単結晶の揺れは複雑であり、両側の交点位置変動の タイミング差8を取り除いて両方の交点位置検出データ $L(\alpha)$, $R(\alpha)$ を比較する場合にあっても、この揺 れは直径測定精度を低下させる大きな要因となる。

【0020】本発明の目的は、測光ラインが結晶中心か ら離れていることに起因して生じる晶癖線付近での直径 測定精度の低下を防ぎ、合わせて単結晶の揺れによる影 響を排除することにより、結晶直径を全周にわたって正 確に測定することができる結晶直径測定方法を提供する ことにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】本発明の結晶直径測定方 法は、結晶融液から単結晶を周方向に回転させながら引

に設置されたカメラにより単結晶と融液の界面位置を測 光し、単結晶の周囲に生じるフュージョンリングとカメ ラの測光ラインとの交点での輝度変化から両側の交点位 置を検出する際に、両側の交点位置をそれぞれ独立に検 出する工程と、両側の交点位置検出データから単結晶の 揺れによる成分を取り除く工程と、カメラの測光ライン の位置により決定される両側の交点位置変動のタイミン グ差を求める工程と、単結晶の揺れによる成分を取り除 いた後の両側の交点位置検出データを、前記タイミング 差を取り除いて比較し、両側の交点の間隔を求めること 10 により単結晶の直径を測定する工程とを包含するもので ある。

【0022】両側の交点位置検出データから単結晶の揺 れによる成分を取り除く方法としては、両側の交点位置 データに対して高速フーリエ変換(FTE: Fast Fourier Transform) 等を実施して、 それぞれの周波数成分を求め、求めた周波数成分のなか から単結晶の揺れの周期に対応する低次の周波数成分を 除去する方法が有効である。

その揺れが非常に小さいときの周波数成分より、単結晶 の形状による成分をオフラインで事前に調査しておき、 この成分を除去対象から除外することが望まれる。

[0024]

【発明の実施の形態】以下に本発明の望ましい実施の形 態について説明する。

【0025】本発明の直径測定方法では、図1に示すよ うに、CZ法の炉体1の外に設置された一次元CCDカ メラ8が使用される。本例では一次元CCDカメラを用 いたが、二次元CCD等の使用も可能である。このカメ 30 ラ8は、炉体に形成された窓9を通して、るつぼ1内の 融液面を直線的に撮像する。そして、図2に示すよう に、引上げ中の単結晶4の周囲に生じるフュージョンリ ングAと一次元CCDカメラ8の測光ラインB-Bを交 差させ、測光ラインB-B上の輝度変化から交点C,C の位置をそれぞれ独立に検出する。この検出は単結晶4 が1回転する間、その回転角に対応して一定ピッチで継 続する。

【0026】CZ法により引上げられる単結晶は、図3 に示すように、その結晶方位に固有な外面周方向位置に 40 晶癖線4aを生じる。同図は結晶方位(100)の場合 を示しており、この場合は90°おきに4本の晶癖線4 aが生じる。而して引上げ中の単結晶4は周方向に回転 している。そのため、測光ラインB-Bを晶癖線4aが 横切るときに、交点Cの位置変動が生じる。

【0027】今、測光ラインB-Bが結晶中心Oを通っ ていると仮定すると、測光ラインB-Bを晶癖線4aを 通過することによって生じる両側の交点C、Cの位置変 動は両側で同じタイミングとなる。つまり、ある晶癖線 4 aが測光ラインB-Bを通過するときに、結晶中心O 50 を挟んで対象位置にある晶癖線4 a も測光ラインB-B

を通過する。 【0028】しかし、実際の引上げでは、測光ラインB -Bは結晶中心Oから一次元CCDカメラ8の側(手前 側) に離れている。そのため、測光ラインB-Bを晶癖 線4aを通過することによって生じる両側の交点C, C

の位置変動は、両側で異なるタイミングとなる。例えば 単結晶4が時計回りで回転している場合は、左側の測定 位置で測光ラインB-Bを晶癖線4aが通過し交点Cの 位置変動を生じた後、右側の測定位置で測光ラインB-Bを晶癖線4aが通過し交点Cの位置変動が生じ、ここ

に両側の交点C、Cの位置変動にタイミング差が生じ

【0029】図6中の実線は、結晶方位(100)の単 結晶を時計回りに回転させながら引上げている場合に一 次元CCDカメラで得られる両側の交点位置検出データ $L(\alpha)$, $R(\alpha)$ である。単結晶の回転に伴い両側の 交点位置検出データL (α), R (α)が晶癖線4aの 通過により変動するが、右側の変動は左側の変動より θ 【0023】その際、単結晶が揺れていないとき或いは 20 だけ遅れて検出される。なお、図6中の破線は、単結晶 の揺れによる成分を除去したあとの両側の交点位置デー $gL'(\alpha), R'(\alpha)$ を示す。

> 【0030】単結晶の直径は急変しないので、本来なら 測光ラインB-Bを晶癖線4aが通過するとき以外は、 交点位置検出データL(α),R(α)は一定のはずで あるが、実際は図6中の実線に示されるように、単結晶 の揺れのために、測光ラインB-Bを晶癖線4aが通過 するとき以外にも、交点位置検出データL(α), R (a) は変化する。そして、この変化は交点位置検出デ -夕 $L(\alpha)$, $R(\alpha)$ のタイミング差 θ と共に、単結 晶の直径測定精度を低下させる大きな原因となる。

> 【0031】そこで、本発明の結晶直径測定方法では、 図4に示すように、両側の交点C, Cの位置を独立に検 出した後、それぞれの交点位置検出データL(α),R (α)から単結晶の揺れによる成分を除去する。これは 例えば次の方法により行うことができる。

【0032】両側の交点位置検出データレ(α), R (α) に対して高速フーリエ変換 (FTE: Fast Fourier Transform)を実施し、それ ぞれの時間関数で表される周波数成分を求める。交点位 置検出データレ(α), R(α) を f(x) で代表し、 その周波数成分を表すと、数式1のようになる。

[0033]

【数1】

 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum a \cdot s i n (n x + \alpha)$

f (x):交点位置検出データ

x:結晶の回転角度

a a : n次の成分振幅

α。:n次の成分の位相差

【0034】また、f(x)の周波数成分を図示すると、図5中の実線のようになる。なお、図5中の破線は、単結晶の揺れが実質的に存在しない場合の周波数成 10分である。

【0035】単結晶は引上げ中に1回転につき1~4回の周期で揺れている。そこで、単結晶の揺れの周期(1~4回)に対応する低次の周波数成分を、単結晶の揺れによるものとして除去する。しかし、これらの揺れ成分を全て除去してしまうと、測定誤差が大きくなる。なぜ* $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x})$

*なら、結晶方位(100)の場合、90°おきに4本の 晶癖線4aが生じるため、4次の周波数成分まで除去す ると、単結晶1回転につき4回含まれる結晶形状による 成分まで除去されてしまうからである。そこで、図5に 示すように、f(x)の3次以下の成分(振幅)は全て 単結晶の揺れの影響として除去するが、4次の成分(振 幅)については単結晶が揺れていないとき或いはその揺 れが非常に小さいときの周波数成分をオフラインで事前 に調査しておき、これと実際の周波数成分との差を単結 晶の揺れによるものとして除去する。つまり、単結晶が 揺れていないとき或いはその揺れが非常に小さいときの 周波数成分を除去対象から除外して残すのである。この ようにして単結晶の揺れによる周波数成分を除去するこ

[0036]

とにより、数式2が得られる。

【数2】

- $\{a_1 \text{ sin } (x+\alpha_1) + a_2 \text{ sin } (2x+\alpha_2) + a_2 \text{ sin } (3x+\alpha_3) + (a_4 - A) \text{ sin } (4x+\alpha_4) \}$

F (x): 補正後データ

A:結晶形状に起因する4次成分の振幅(予め設定)

【0037】なお、図5中に破線で示す単結晶の揺れが 実質的に存在しない場合の周波数成分においても、1~3次の項にスペクトルが存在する。(100)方位の単結晶の場合、1~3次の項に結晶形状成分は存在しないので、この1~3次の項のスペクトルは振幅が0.2mm以下の非常に小さい結晶揺れによるものと考えられる。【0038】両側の交点位置検出データL(α),R(α)につき、単結晶の揺れによる成分を除去したデー 30 タL'(α),R'(α)が得られると、図6に示すように、その交点位置検出データL'(α),R'(α)のズレから両側の交点位置変動のタイミング差 θ を求める。そして、このタイミング差 θ を取り除くため、数式3を用いて、両側の交点C、Cの間隔W(α)を求める(図7、8参照)。

[0039]

【数3】W(α) =R'(α + θ) -L'(α)

【0040】単結晶4が反時計回りに回転しながら引上 げられる場合は、数式4により両側の交点C, Cの間隔 40 W(α)を求める。

[0041]

【数4】 $W(\alpha) = R'(\alpha) - L'(\alpha + \theta)$

【0042】そして、測定された間隔 $W(\alpha)$ は、数式 5を用いて結晶直径 $D(\alpha)$ に換算される。

[0043]

【数5】 $D = (W^2 + 4a^2)^{1/2}$

【0044】本発明の方法では、図6,7に示すように、両側の交点位置変動のタイミング差 8 を除去するだけでなく、単結晶の揺れによる影響を除去する。その結※50

※果、結晶直径 $D(\alpha)$ は、図8に示すように正確に測定される。図8中の破線はタイミング差 θ のみを除去した場合、実線はタイミング差 θ と共に単結晶の揺れによる影響を除去した場合である。

【0045】ここで、結晶中心から測光ラインB-Bまでの距離 a は、融液 3 の液面位置が上下することに伴い変化するが、その距離 a が変化すると、両側の交点位置変動のタイミング差 θ も変化する。すなわち、結晶中心のから測光ラインB-Bまでの距離 a が大きくなるにつれて、タイミング差 θ も大きくなる。そこで、タイミング差 θ を用いて数式 θ により距離 a を補正することができる。

[0046]

【数6】 $a = Wavg / 2 \cdot sin^{-1} (\theta / 2)$

Wavg : 前回測定時の平均間隔

【0047】これにより、融液面のレベル変化による測 定誤差も排除される。

【0048】交点C、Cの位置を検出するピッチは、晶 癖線付近の形状を正確にとらえるために引上げ中の単結 晶の回転角度で2°以下が望ましい。このピッチを1° にして本発明を実施したところ、従来法では正確に測定 できなかった晶癖線付近を通る直径についても、その直 径を正確に測定でき、直径および変形率ともに誤差が従 来法の場合の半分以下になることが確認された。また、 測定された直径から晶癖線の位置が正確に検出されるよ うになったため、引上げ中の単結晶の多結晶化監視の自 動化も可能になった。

[0049]

【発明の効果】以上に説明した通り、本発明の結晶直径 測定方法は、晶癖線による両側交点位置変動のタイミン グ差を検出し、そのタイミング差による測定誤差を排除 すると共に、単結晶の揺れによる影響を排除するので、 晶癖線付近を含む結晶全周について直径を高精度に測定 することができ、これによる変形率の検出精度向上等に より歩留り改善、生産性改善、品質改善等に大きな効果 を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】CZ法による単結晶引上げの装置構成図である。

【図2】単結晶の直径を測定する方法の概念図である。

【図3】 ラインセンサの測光ラインと結晶中心の位置関係を示す模式平面図である。

【図4】本発明の方法における直径計測手順を示すフローチャートである。

【図5】交点位置検出データの周波数成分を示すグラフである。

【図6】両側の交点位置検出データを、結晶揺れの影響を除去した場合と除去しない場合について示すグラフである。

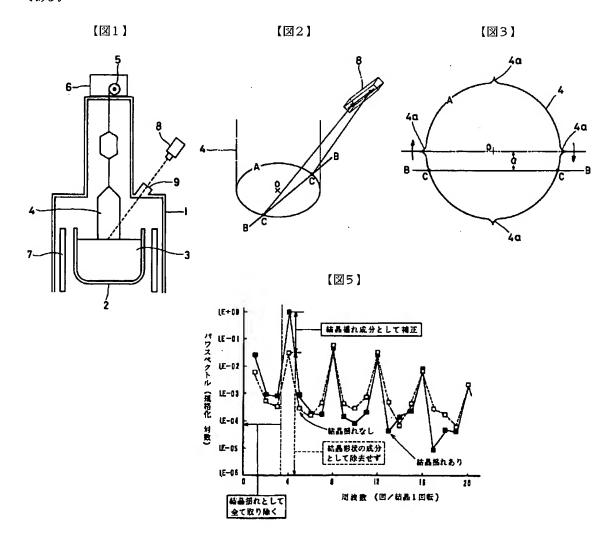
10

【図7】交点位置変動のタイミング差 θ を除去したあとの交点位置検出データを示すグラフである。

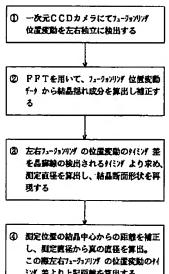
【図8】両側の交点位置検出データから求めた結晶直径 データを、結晶揺れの影響を除去した場合と除去しない 場合について示すグラフである。

【符号の説明】

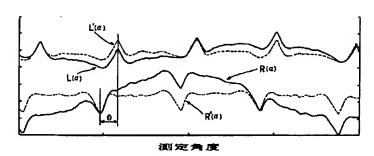
- 10 1 炉体
 - 3 融液
 - 4 単結晶
 - 8 一次元CCDカメラ
 - A フュージョンリング
 - B 測光ライン
 - C フュージョンリングと測光ラインの交点
 - 〇 結晶中心



【図4】

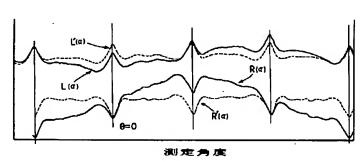


【図6】



ミング 差より上記距離を算出する

【図7】



【図8】

